УДК 544.653.23, 544.654.2

В.В. Жилинский, доц., канд. хим. наук, <u>zhilinski@yandex.ru</u> А.В. Пянко, магистрант; Н.В. Богомазова, доц., канд. хим. наук (БГТУ, г. Минск)

Г.Г. Горох, канд. техн. наук, зав. НИЛ «Нанотехнологии» gorokh@bsuir.by А.И. Захлебаева, науч. сотр. НИЛ «Нанотехнологии» (БГУИР, г. Минск)

ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ОЛОВА И ЦИНКА В МАТРИЦАХ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ XEMOPE3ИСТИВНЫХ СЕНСОРОВ

Хеморезистивные полупроводниковые сенсоры широко используются для обнаружения токсичных и горючих газов, представляющих опасность для человека и окружающей среды. Благодаря технологичности, стабильности характеристик и высокой чувствительности к малым концентрациям газов, широкое распространение, получили сенсоры с газочувствительными слоями на основе тонких металлооксидных пленок. Принцип работы таких сенсоров заключается в изменении электропроводности металлооксидов в результате реакций адсорбции-десорбции, протекающих на их поверхности при взаимодействии с газовой средой.

Наиболее распространенным газочувствительным материалом является диоксид олова, обладающий высокой адсорбционной способностью, термической и химической устойчивостью [1]. Ввиду недостаточной чувствительности диоксида олова и отсутствия у него селективности к газам различной химической природы, в его состав дополнительно вводят различные модификаторы, оказывающие положительное влияние на адсорбционно-каталитические и электронные свойства и выступающие как активаторы сорбционных процессов [1]. Повысить чувствительность хеморезистивных сенсоров также можно за счет увеличения площади взаимодействия молекул адсорбируемых газов с газочувствительным материалом. Одним из наиболее перспективных подходов является увеличение эффективной площади газочувствительных слоев при формировании тонких пленок на поверхности диэлектрических структурированных матриц [1].

Наиболее подходящим материалом для формирования структурированных газочувствительных слоев является пористый анодный оксид алюминия (AOA), обладающий уникальной ячеисто-пористой структурой, хорошей механической прочностью и высокими показателями жесткости, упругости и износостойкости.

В настоящей работе представлены результаты формирования структурированных пленок SnO_2 ·ZnO в пористых матрицах AOA и

исследования их структурных параметров и газочувствительных характеристик.

Формирование АОА проводили в электрохимических условиях, обеспечивающих размер и профиль пор, позволяющий равномерно заполнить матрицу газочувствительным материалом. В качестве исходных образцов использовали кремниевые подложки п-типа проводимости (4,5 Ом⋅см) с кристаллической ориентацией (111), на которые методом магнетронного напыления в вакууме был нанесен слой Al толщиной 1,2 мкм. Матрицу АОА формировали методом двухстадийного электрохимического анодирования в 0,4 М водном растворе винной кислоты при плотности анодного тока 6 мА/см². Напряжение стационарного роста пористого оксида составляло 200 В. Сформированный на первой стадии анодирования слой пористого оксида толщиной 0,5 мкм селективно удаляли в нагретом до 80°C водном растворе хромового ангидрида и ортофосфорной кислоты, в результате чего поверхность непроанодированного алюминия была структурирована отпечатками оксидных ячеек. На структурированной поверхности алюминия формировали упорядоченный слой АОА в электрохимических условиях, аналогичных первой стадии. Схематически этапы формирования АОА показаны на рисунке 1.



Рисунок 1 – Формирование матрицы АОА

Фотографии поверхности и скола сформированных АОА матриц приведены на рисунке 2.

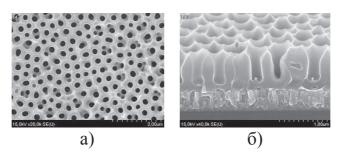


Рисунок 2 – Поверхность (а) и скол (б) АОА матрицы

Химическое наполнение пористой структуры AOA (4 см²) осуществляли путем послойного осаждения гидроксидов металлов из подщелаченных растворов 0,01 M ZnSO₄ и SnSO₄ при рН 8. Количество слоев гидроксидов олова и цинка, соосажденных на поверхность AOA, не превышало 4. Полученные таким образом слои гидроксидов

металлов на поверхности AOA после естественной сушке подвергали отжигу при температуре 750^{0} C до полного перехода Sn^{+2} в Sn^{+4} и формировании смешанного оксида $\mathrm{SnO}_{2}{\cdot}\mathrm{ZnO}$.

В ряде случаев хеморезистивные слои на основе SnO_2 получали электрохимическим окислением ионов Sn^{2+} в водных растворах на поверхности AOA (рисунок 3).

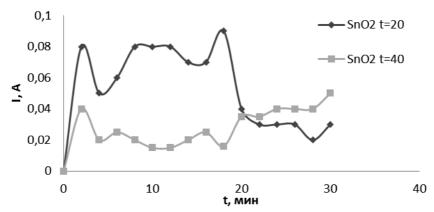


Рисунок 3 – Хроноамперограмма процесса заполнения пористой матрицы AOA оксидом олова(IV) из 0,01 M SnSO₄ (pH 2)

Следует отметить, что электрохимический процесс окисления ${\rm Sn}^{2+}$ наиболее интенсивно протекает при температуре $20^{\rm o}{\rm C}$ до начала процесса гидролиза соли. Далее на полученную пленку ${\rm SnO}_2$ химически осаждали слой гидроксида цинка и отжигали при $600^{\rm o}{\rm C}$ до формирования кристаллической фазы ${\rm SnO}_2{\cdot}{\rm ZnO}$.

В ходе экспериментов определены оптимальные условия, сочетающие стабильность и достаточно высокой чувствительностью полученных сенсоров. Изучено кинетика процесса сорбции и десорбции газов на поверхности тонких пленок $SnO_2 \cdot ZnO$. Структурированные газочувствительные пленки $SnO_2 \cdot ZnO$, сформированные электрохимическим окислением ионов Sn^{2+} и химическим осаждением ZnO, показали приемлемые отклики на NO_2 с максимальной чувствительностью при температуре $450^{\circ}C$.

ЛИТЕРАТУРА

1 Gorokh, G. Anodic formation of low-aspect-ratio porous alumina films for metal-oxide sensor application / G. Gorokh [et al.] // Electrochimica Acta. – 2006. – Vol. 52. – P. 1771–1780.